# 電界放出カソードのイオン衝撃による電極損耗

○田中善信,島田温子(静大工・院),井本伸(静大工) 大川恭志(JAXA),山極芳樹,松井信(静大工)

Keyword : Field Emission Cathode, Carbon Nanotube, Ion Bombardment

## 1. 目的および背景

現在 JAXA にてカーボンナノチューブ(CNT)を使用した電 界放出型カソード(FEC)について研究・開発が行われている. FEC は、電子を宇宙空間へ放出する電子放出装置の一つである. 他の電子放出装置に比べ、作動ガスが不要で小型化が容易であ ることなどから、エレクトロダイナミックテザー(EDT)シス テム<sup>(1)</sup>への適用が期待されている.

EDT システムは、テザーに電流を流すことで地球磁場との間 に発生するローレンツ力を利用し、推力を得るシステムである (図1).推進剤不要で推力を得られることから、軌道上の大型 のデブリ安価に排除するためのシステムとして期待されている.

しかし, EDT システムでは、地球磁場という微弱な磁力を用いて推力を得るため、大型のデブリを地球周回軌道から遷移させるためには、約260日(6000時間)程度かかると試算されている<sup>(2)</sup>. そのため、JAXAでFECの耐久性能評価のため、長時間動作実験が行われた<sup>(3)</sup>.

本研究では、長時間動作実験で生じる電極損耗と電子放出性 能の変化に関する実験・解析結果を報告する.



Fig.1 EDT 概略図

#### 2. 電界放出型カソード(FEC)

電界放出とはゲート電極,エミッタ電極の2枚の電極間に強 電界を印加することでエミッタ電極から電子を引き出す電子放 出方法である.本来,電子を真空中に放出するには,電位障壁 を超えるようなエネルギを電子に与えなければならないが,電 界放出では固体表面に強電界を印加することで,電子に対する 電位障壁が非常に薄くなることを利用している.これによって, 電子は自身の持つ波動性から,薄くなった電位障壁を透過する (トンネル効果という)ことで固体中から放出される.エミッ タ電極に尖鋭性の良い CNT を用いることによって,表面電場を 強めることができ,より低い印加電圧でも大きな電流を得るこ とができる<sup>(4)</sup>. そのため JAXA では CNT-FEC を用いて研究を行 っている.図2に本研究で使用する FEC の電界放出の原理図を 示す.



Fig. 2 電界放出原理

電界放出により得られる電流密度 j [A/m<sup>2</sup>] は電場 E [V/m], エミッタの仕事関数  $\phi$  [eV], プランク定数 h,素電荷 e,電子質 量  $m_e$ を用いて,以下の Fowler-Nordheim の式により与えられる.

$$j = \frac{e^3 E^2}{8\pi h\phi} \exp\left(-\frac{8\pi\sqrt{2m_e}}{3heE}\phi^{\frac{3}{2}}\right) \tag{1}$$

ここで,電界 E,エミッタの仕事関数 Ø以外は定数であるので, 電界放出電流は, E および Øに依存する.さらに電場 E はゲート - エミッタ電極間の電位差 V[V]に比例しゲート - エミッタ電 極間距離 d [m] に反比例するため、電極間隔が一定の場合、電 圧を制御することで電界放出電流を制御することが出来る.

# 3. 長時間動作実験による電極損耗

JAXA で行われた長時間動作実験は、図3に示す8つのカソ ードユニットからなる8ch-FECを用いて行われた.一定量の電 子放出に必要な電圧の個体差を補正するため、8つのエミッタ電 極はそれぞれ異なる調整抵抗を介して電源に接続されている. 実験に使用した各カソードユニットの構成を図4に示す.

実験はターボ分子ポンプとオイルロータリーポンプからなる 排気系によって 5×10<sup>5</sup>[Pa]まで減圧された真空チャンバ内で行 われる.チャンバ内に積極的なガス導入は行っていないため, 残留ガスの主成分はチャンバ壁面に吸着した水分子であると考 えられる.



Fig.4 カソードユニット回路図

長時間動作の結果,エミッタの電子放出性能は徐々に劣化 (3mAの電子放出に必要な電圧が上昇)していき,1500時間で動 作電圧が1000Vに到達し、実験は終了した(図5).実験中、No.8 のエミッタ電極で絶縁破壊による損傷及び電流・電圧の急激な 変動が確認されたが、他の7つのエミッタでは絶縁破壊は観測 されなかった.

長時間動作実験後のエミッタを観察したところ, No.3,4,5,6の エミッタに,同様の形状の損耗が見られた.そのうち最もはっ きりと損耗が現れた No.4 の写真を図6に示す.電極表面が損耗 する理由には,ジュール熱による CNT の損傷,静電場による CNT の引き抜き,残留ガスと CNT の化学反応による酸化など が考えられるが,観察の結果,この損耗は電子との衝突によっ てイオン化された残留ガスがエミッタ電極表面をスパッタした ために生じたものであると推測された<sup>(5)</sup>.



Fig. 5 3mA の電子放出と、電子放出維持のためエミッタ電極 に印加された電源電圧の時間変化(1500時間実験)



Fig.6 ゲート電極真上からの俯瞰図(No.4, 1500 時間実験)

### 4. イオン数密度変更実験

エミッタ電極表面に生じた模様が、イオン衝撃によるもので あることを確認するため、8ch-FECを用いて 150 時間の長時間 動作実験を行った.この実験ではエミッタ・マスク・ゲート電 極は新品のものを使用しており,調整抵抗の値も異なるが,そ の他の実験装置の構成は1500時間動作実験と同じである.また, 1500時間の動作実験に対して,動作時間を減らしてイオン衝撃 以外の損耗要因を減らすと共に,Arガスを導入することにより 雰囲気ガス圧を高めてイオン生成量を増やし,イオン衝撃によ る影響を加速することで1500時間動作実験と同程度のイオン流 入を確保している.1500時間動作実験と150時間動作実験での 実験条件を比較した表を以下に示す.

	単位	1500 時間実験	150 時間実験
動作時間	hour	1500	150
チャンバ内ガス種	-	H <sub>2</sub> O	Ar
チャンバ圧力	Pa	5×10 <sup>-5</sup>	5×10 <sup>-4</sup>
エミッタ電流	mA	3	
シールド電位	V	接地	
ゲート電位	V	接地	
マスク電位	V	エミッタと同電位	
エミッタ電位	V	3mA 電子放出に必要な電圧	

Table 1 1500 時間・150 時間動作実験条件

150 時間実験の結果,1500 時間実験と同様にエミッタの電子 放出性能は徐々に劣化していき,150 時間で動作電圧が約1000V まで到達した(図7).長時間動作実験後のエミッタを観察したと ころ,No.3 のエミッタに,1500 時間動作実験で観察されたもの と同等の損耗が見られた(図8).これらの結果から,エミッタ電 極表面に現れた模様はイオン衝撃によるものであること,イオ ン衝撃と電子放出性能劣化の間に関係があることがわかった.

EDT システムはスペースデブリの分布及びテザー寿命から, 高度 800~1000km での運用が想定される.軌道高度 1000km では O+および H+が支配的であり,エミッタ電極電位が-1000V の時, エミッタへのイオンフラックスは O+と H+を合わせて最大で 2.5×10<sup>15</sup>ions/m<sup>2</sup>s 程度になる.これに対し,地上実験で生成され るイオンフラックスは 1500 時間実験において 7.47×10<sup>15</sup>ions/m<sup>2</sup>s 程度であり,軌道上でのイオンフラックスに対して 3 倍程度の 影響があったと考えられる.

EDT システムの運用期間は約 260 日(6000 時間)程度になると 試算されており、地上実験における寿命の 4 倍が要求される. 次章以降では、イオン衝撃が電子放出性能劣化速度に与える影響を評価し、その対策を検討した.



Fig. 7 3mA の電子放出と、電子放出維持のためエミッタ電極 に印加された電源電圧の時間変化(150時間実験)



Fig.8 ゲート電極真上からの俯瞰図(No.3, 150時間実験)

#### 5. イオン衝撃による電子放出性能劣化

本章ではカソードの各電極電位およびアノード電位を任意に 操作することで、生成されたイオンの流入先を制御し、イオン 衝撃の影響度を確認した.

エミッタ電極に負電位を印加し、ゲート電位とアノード電位 を接地電位とすると、イオンは大きく負に帯電したエミッタ電 極によって回収さる.これに対し、エミッタ電位をアノード電 位と同じにし、ゲート電極に正電位を印加すると、イオンはゲ ートの正電位に反発してアノードに回収される.このように電 極電位を操作することでイオン衝撃を防ぐこともできるが、こ の場合ほとんど全ての電子がゲート電極に回収されてしまい、 電子放出装置としての機能不全に陥ってしまうため、この電位 条件をとることはできない.

これらの実験回路図と実験条件を図9、表2に示す.なお、本

実験ではイオン衝撃による影響を明らかにするため, 8ch-FEC においてシールド電極を用いず,カソードユニット8台のうち1 台のみを用いて実験を行った.





Table 2 実験条件						
		イオン衝撃あり	イオン衝撃なし			
ガス種	-	Ar				
チャンバ圧	Ра	5×10 <sup>-4</sup>				
エミッタ電流	mA	0.5				
動作時間	hour	6				
アノード電位	V	接地				
マスク電位	V	エミッタ電極と同電位				
ゲート電位	V	接地	0.5mA 電子放出に			
			必要な正電位			
エミッタ電位	V	0.5mA 電子放出に	接地			
		必要な負電位				

本実験では、電子放出性能の劣化を、0.5mA の電子放出電流 に必要となる電圧の変動を用いて評価する.この電圧変動はば らつきが多く、特に電子放出開始時には不安定になる傾向が経 験上得られている.本実験は、再現性の確認のためイオン衝撃 なし、イオン衝撃あり、イオン衝撃なしの順で繰り返し実験を 行っているが、図 10 に示すように、各回とも初めの2時間程度 が特に不安定になる.一定時間電子放出を行うことにより、電 圧変動が安定する傾向から、この不安定性の原因として、残留 ガス吸着による CNT からの電子放出不安定<sup>60</sup>が考えられるが、 詳細は不明である.このことから、本実験での電子放出性能劣 化速度比較においては、始めの2時間分のデータを除いた、残 り4時間のデータを比較に用いた. 電圧の時間変化でイオン衝撃の有無を比較した結果を図11に 示す.この図から、イオン衝撃ありの場合、イオン衝撃なしに 比べて電圧上昇が 5V/hour 程度早く、約2倍の速度で劣化して いくことがわかる.また、イオン衝撃なしの電極電位状態で実 験を繰り返したところ、イオン衝撃ありの場合に比べて十分小 さい誤差範囲内で再現性が得られた.

この結果から、電子放出性能劣化におけるイオン衝撃の影響 度はおよそ5割程度であることがわかる.



Fig. 10 電子放出性能劣化速度比較



Fig. 11 電子放出性能劣化速度比較

## 6. シールド開口径によるイオン衝撃対策

イオン衝撃対策として、シールド開口径を変化させることの 効果を数値解析的に検討した.本解析ではまず PIC 法<sup>の</sup>を用いて 電子軌道を計算した.そのうえで、各グリッドの電子流量に対 応したイオンを配置し、静電場中でのイオン軌道を計算した. ただし、本実験では外部磁場を加えておらず、電子電流によっ て発生する磁場変動も微弱であるため、磁場は無視して計算を 行っている.境界は、上下右端を開放系条件、カソード対称軸 となる左端を反射境界条件とした.

本解析では、ここまでの実験で使用してきた 8ch-FEC ではな く、簡素化のため平らなシールド形状を持ち、一つのカソード ユニットからなる 1ch-FEC (図 13) について解析する. 解析の 流れ (図 12) と解析条件 (表 2), 解析モデル概要を以下に示す.



Fig. 12 解析フローチャート

表2 解析条件					
イオン種	-	Ar+			
シールド開口径	mm	φ1,2,3,4,5,7,10			
計算領域	mm×mm	20×30			
計算格子	mm	0.05			
エミッション電流	mA	0.5			
アノード電極(チャンバ壁)電位	V	接地			
シールド電極電位	V	接地			
ゲート電極電位	V	接地			
マスク電極電位	V	-1000V			
エミッタ電極電位	V	-1000V			



Fig.13 計算領域と、境界条件

解析結果を図14に示す. 図中の電子放出効率とは、各シール ド電極開口径において、エミッタ電極から放出された電子のう ちシールド電極に回収されることなく、カソード系の外に放出 される電子の比率を示す. このグラフから, φ7 までは電子がシ ールド電極に回収されることなく放出されるが、φ7以下ではシ ールド径が狭くなるにつれて電子放出効率が低下することがわ かる.これは、エミッタ電極から放出された電子がシールド電 極に回収されてしまうためである.

解析結果におけるイオン流入数比率とは、各シールド開口径 においてエミッタ電極に流入するイオン数を、シールド開口径 が φ10 の時にエミッタ電極へ流入するイオン数を基準とした数 比率で表したものである.この結果を見ると、シールド径を狭 めるに従い、エミッタ電極へのイオン流入数が減っていってい ることがわかる.しかし、このイオン流入数減少のほとんどは、 シールド電極に電子が回収されることによって電子放出効率が 低下したために、初期イオン生成数が減少したことによるもの である.

計算結果からは、シールド径を φ10 から φ4 にしたとしても、 イオン流入量は9%程度しか抑えられず、イオン衝撃による性能 劣化が全体の電子放出性能劣化の半分を占めるとして計算して も、寿命は5%程度しか伸びない. それに対し、電子放出効率が 12%程度も低下してしまうため、シールド電極開口径によるイ オン衝撃対策は非効率であると考えられる.



# 7. 引出電極構成によるイオン衝撃対策

本章では、もう一つのイオン衝撃対策として、電子引出をマ スク電極1枚、ゲート電極1枚の合計2枚で行う従来の方法に 対し、マスク電極2枚、ゲート電極1枚の合計3枚で行う場合 のイオン流入について検討した.引出電極3枚でのカソード構成を図15に示す.



Fig. 15 3枚引出電極によるカソード構成

引出電極を3枚にすると、エミッタ電極表面の電場強度はお よそ28%低下してしまう.これは、ゲート電極上部にエミッタ 電極と同じ負電位を持ったマスク電極が現れたことで、エミッ タ電極-ゲート電極間の電場強度が弱まるためである.そのため、 3枚電極構造において2枚電極状態と同量の電子放出を行うた めには、エミッタ電極-ゲート電極間電位差を約1.4倍にしなけ ればならない.そのため、イオン流入の比較を行う際には、2 枚電極構成の場合はエミッタ電極電位を-700V、3枚電極構成の 場合には-1000Vとして解析を行った.解析手法は、マスク電極 が増えたこと以外はシールド開口径によるイオン衝撃対策で行 った解析と同じである.ただし、シールド開口径はφ10とした.

両カソード構成において、各電極及び計算領域外に流出した イオン数比率の解析結果を図16に示す.この図から、3枚電極 構成にすることでマスク電極へのイオン流入量が増え、エミッ タ電極へのイオン流入を約30%削減できると予想される.4章 で述べたように、イオン衝撃による電子放出性能劣化が全体の およそ半分を占めていると仮定すると、そのさらに3割が3枚 電極構成によって改善されるので、全体として性能劣化速度を 15%低減することができる.

本研究で行った長時間の動作実験では調整抵抗を用いていた が、実際の運用では冗長性を持たせるため、各カソードユニッ トに別々の電源を用いると考えられる.そのため、調整抵抗に よる電流調整の必要がなくなり、調整抵抗における電圧降下が なくなり、より低い電源電圧で電子放出が可能になる.そのた め、表面電場強度が28%低下したとしても、2枚電極構成より も長寿命化が図れると考えられる.しかし、軌道上での運用時 間である約260日(6000時間)程度の寿命を達成するには、さら に低い電圧で電子放出できるように改善していく必要がある.





### 8. まとめ

EDTシステムへの適用を目的としたFECの長時間動作試験の 結果,エミッタ電極表面がイオン衝撃によって損耗するととも に,電子放出に必要な電位差が上昇することがわかった.

イオン衝撃への対策としてシールド開口径を変更したが、イ オン流入の低減には有効でないことがわかった.しかし、引出 電極構成を変えることでイオン流入を防ぐことができ、寿命向 上に有効であることがわかった.

今後の課題として,引出電極構成を変えた時の電子放出性能 の向上,イオン衝撃以外の電子放出性能劣化要因の調査及び対 策が挙げられる.

#### 参考文献

- 山極芳樹, "エレクトロダイナミックテザー",日本航空宇 宙学会誌,第52巻,第603号,2004
- Satomi Kawamoto, "Strategy for Active Debris Removal Using Electrodynamic Tether", Trans. JASS Space Tech. Japan, Vol. 7, No. ists26, pp. Pr\_2\_7-Pr\_2\_12, 2009
- Yasushi Ohkawa, "A Carbon Nanotube Field Emission Cathode for Electrodynamic Tether Systems", IEPC, 2011
- 4) 小間篤, "表面物性工学ハンドブック第2版", 丸善, 2007
- Yoshinobu Tanaka, "Durability Characteristics of Carbon Nanotube Field Emission Cathode", ists29, 2013
- 6) 畑浩一,"多層カーボンナノチューブ清浄表面での各種単
  ーガス分子の吸着挙動と反応性",応用物理,第78巻,第4
  号,2009
- 電気学会・マイクロ波プラズマ調査専門委員会編、"マイク ロ波プラズマの技術"、オーム社、2003